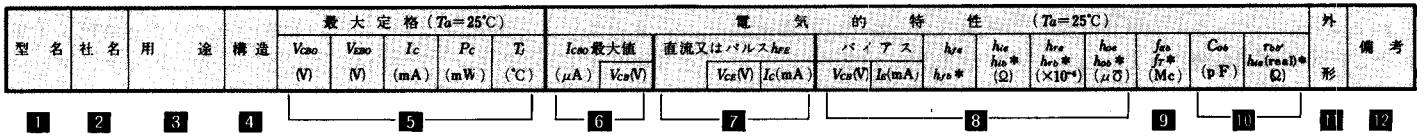
FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.



1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

:とコンプリ: COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)		
2SA863																								
〃 864																								
〃 865																								
〃 866	新日無	RF	Si. EP	−30	−5	−100	300	125	−0.1	−20	250	−6	−1	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50pS	138D	
〃 867	〃	〃	〃	−60	−5	−100	300	125	−0.1	−20	250	−6	−1	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50pS	138D	
〃 868	〃	〃	〃	−90	−5	−100	300	125	−0.1	−20	250	−6	−1	−10	2					150*	4	$C_c r_{bb'}$ 50pS	138D	
〃 869	〃	〃	〃	−30	−5	−400	500	125	−0.5	−20	200	−1	−100	−10	5					150*	8	$C_c r_{bb'}$ 50pS	138D	
〃 870	〃	〃	〃	−60	−5	−400	500	125	−0.5	−20	200	−1	−100	−10	5					150*	8		138D	
〃 871	〃	RF. AF. LN	〃	−30	−5	−50	200	125	−0.05	−20	250	−6	−1	−6	0.3		50 k	4	10	120*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 55pS	138D	
〃 872	日立	LN	Si. E	−90	−5	−50	300	125	−0.5	−75	250~800	−12	−2	−12	2	NF<1.5dB (f=1kHz, V_{CE}=−6V, I_c=−50μA)				120*	1.8		138	2SC1775 とコンプリ
〃 873	富士通	RF	Si. EP	−60	−6	−200	300	150	−0.5	−40	140	−1	−10	−10	10					220*	5	70*	275	
〃 874	東洋電具	AF.SW	〃	−40	−5	−500	300	125	−1	−20	82~390	−3	−100	−5	20					200*	7.5		235	2SC1652 とコンプリ
〃 875																								
〃 876	日立	RF. SW	Si.E	−70	−5	−500	350	175	−0.5	−50	80~240	−3	−10	−3	10	t_{on}=35nS, t_{off}=300nS, t_{stg}=250nS				200*	10		49C	
〃 877	サンケン	PA	Si.EMe	−80	−6	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−100	−80	60	−4	−3A	−12	500					15*	255	10*	102	
〃 878	〃	〃	〃	−120	−6	−10A	100W (T_c=25°C)	150	−100	−120	60	−4	−3A	−12	500					15*	255	10*	102	
〃 879	松下	RF. AF	Si. EP	−250	−5	−70	600	135	−10	−250	100	−10	−5	−10	3		300	0.4	2.7	80*	5	$C_c r_{bb'}$ 60pS	165	
〃 880	〃	RF. LN	Si. EP	−35	−5	−50	150	125	−0.1	−10	540	−5	−2	−5	2		3.5k	3	60	120*	5	100	276	2SC1787 とコンプリ
〃 881	東洋電具	RF. AF	〃	−40	−5	−1A	600	125	−0.5	−20	180	−3	−100	−5	50					150*	20	$C_c r_{bb'}$ 80pS	235	
★ 〃 882	松下	PA	Si.EMe	−130	−5	−7A	100W (T_c=25°C)	150	−500	−70	150	−5	−7A	−10	500					7*	800	10	102	
〃 883	日電	RF. SW	Si. E	−60	−8	−200	300	150	−0.1	−40	160	−1	−10	−10	10	t_{on}=100nS, t_{off}=270nS, t_{stg}=200nS				280*	7.5		138	
〃 884	ソニー	RF	〃	−65	−5	−200	270	120	−0.5	−50	250	−3	−1	−6	2					140*	6	$C_c r_{bb'}$ 60pS	277	P_c=250mW /unit
〃 885	松下	PA	Si. EP	−45	−5	−1A	1.2W	150	−0.1	−20	160	−10	−500	−10	50					200*	22	3.5k*	222	2SC1846 とコンプリ
〃 886	〃	〃	〃	−50	−5	−1.5A	1.2W	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	50	3.3k*	222	2SC1847 とコンプリ
〃 887	〃	〃	〃	−70	−5	−2A	1.2W	150	−1	−40	130	−5	−1A	−5	500					150*	50	3k*	161	2SC1848 とコンプリ
〃 888	〃	RF. AF	〃	−25	−5	−50	350	135	−1	−10	250	−5	−2	−5	2	150	3 k	3	50	100*	2.7	100	138D	2SC1849 とコンプリ
〃 889	〃	〃	〃	−45	−5	−50	350	135	−1	−10	250	−5	−2	−5	2	150	3 k	3	50	100*	2.7	100	138D	2SC1850 とコンプリ
〃 890	〃	PA	〃	−30	−5	−500	625	135	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5k*	138D	2SC1851 とコンプリ
〃 891	〃	〃	〃	−60	−5	−500	625	135	−0.1	−20	160	−10	−150	−10	50					200*	6	3.5k*	138D	2SC1852 とコンプリ
〃 892	サンケン	SW	〃	−40	−6	−6A	40W (T_c=25°C)	150	−100	−40	>300	−4	−5A	−12	100	t_r=0.7μS, t_f=0.7μS, t_{stg}=1.2μS				15*			298	ダーリントン